



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



بررسی تاثیر شکل پالس پمپ در تقویت پارامتری پالس‌های نوری چیرپ شده

زهرا رجب‌لو، فاضل جهانگیری، رضا مسعودی

پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده - در این مقاله تاثیر شکل و طول زمانی پالس‌های لیزری برهم‌کنش کننده در روش تقویت پارامتری پالس‌های نوری چیرپ شده بر طول بهینه کریستال، بازده و پهنای باند بهره مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج عددی حاصل نشان می‌دهند استفاده از پروفایل زمانی تخت برای پالس پمپ می‌تواند باعث افزایش بازده و پهنای باند پالس تقویت شده شود.

کلید واژه - تقویت پارامتری، چیرپ، پهنای باند، پروفایل زمانی.

The effect of pump pulse shape on the efficiency and bandwidth of optical parametric chirped pulse amplification

Z.Rjabloo, F.jahangiri, R.massudi

Laser and plasma research institute, University of Shahid beheshti, Evin, Tehran

Abstract-The effect of input laser pulse parameters including its temporal profile and length on the efficiency, gain bandwidth and the optimum crystal length, for an optical parametric chirped pulse amplification, is investigated. The results show that the gain bandwidth and efficiency can be maximized by employing pump pulses with flat-top temporal profiles.

Keywords: parametric amplification, chirp, bandwidth, temporal profile.

مقدمه

تقویت پارامتری پالس‌های نوری چیرپ شده (OPCPA^۱) امروزه روش شناخته شده‌ای برای تولید پالس‌های لیزری با قله توان بالا می‌باشد. بالا بردن قله توان پالس تقویت شده از طریق بهینه سازی بازده تبدیل پمپ به سیگنال و ایدلر و یا پهنای باند بهره، توجه ویژه‌ای را در این موضوع به خود جلب کرده‌است. توصیف تحلیلی از این پدیده غیرخطی می‌تواند به شفافیت فیزیکی و رویکردهای جدید بهینه‌سازی و بررسی‌های عددی و تجربی کمک کند. حل دقیق تحلیلی پدیده مخلوط سه موج^۲ که توصیف کننده این اثر غیر خطی است با استفاده از توابع بیضوی ژاکوبی ارائه شده است [۱،۲]. اما از آنجا که این حل تحلیلی تنها قادر به توصیف برهم کنش‌های شبه تکفام در جایی است که اثرات پاشندگی انتشار می‌تواند نادیده گرفته شود، کاربرد کمی در OPAها با پالس‌های فوق کوتاه داشته اند. با این حال OPCPA فرآیندی است که این معادلات در آن معتبر است و دلیل آن اولاً چیرپ خطی بالایی است که به پالس سیگنال قبل از ارسال آن به تقویت کننده اعمال می‌شود و ثانیاً ناچیز بودن اختلاف سرعت بین پالس‌های تقویت شده و پمپ در مقایسه با طول پیکوتانیه‌ای آن‌ها می‌باشد. برآورده شدن این ملزومات با عنوان تقریب محلی^۳ شناخته شده و در OPCPAهای عظیم به کار می‌رود. در این بررسی تاثیر شکل دهی زمانی پالس بر افزایش قله توان OPCPA را نشان می‌دهیم و مشاهده می‌کنیم تخت بودن پروفایل پالس پمپ منجر به کاهش باریک شدگی بهره و بهبود بازده می‌شود.

تئوری

با شروع از معادلات غیرخطی مرتبه اول برای مخلوط سه موج تخت تکفام در یک محیط دی الکتریک، معادلاتی برای تغییرات شدت پمپ، ایدلر و سیگنال به دست می‌آید که توابعی از فاصله انتشار z می‌باشند [۳].

$$I_s(z) = I_{s0} + \frac{\omega_s}{\omega_p} I_{p0} cn^2 \left[\sqrt{\frac{I'_{p0}}{I_{p0}}} \frac{\Gamma}{\gamma} z + K(\gamma), \gamma \right]$$

$$I_i(z) = \frac{\omega_i}{\omega_p} I_{p0} cn^2 \left[\sqrt{\frac{I'_{p0}}{I_{p0}}} \frac{\Gamma}{\gamma} z + K(\gamma), \gamma \right] \quad (۱)$$

$$I_p(z) = I_{p0} - I_{p0} cn^2 \left[\sqrt{\frac{I'_{p0}}{I_{p0}}} \frac{\Gamma}{\gamma} z + K(\gamma), \gamma \right]$$

که:

$$I'_{p0} = I_{p0} - (\alpha - \beta) / 2, \gamma = \sqrt{\frac{I'_{p0}}{\beta}}$$

$$\beta = \sqrt{\alpha^2 - \frac{\Delta k^2}{\Gamma^2} I_{p0}^2}, \alpha = \frac{\omega_p}{\omega_s} I_{s0} + \left(1 + \frac{\Delta k^2}{4\Gamma^2}\right) I_{p0}$$

$$\Gamma = \sqrt{\frac{2\omega_s \omega_i I_{p0} d_{eff}^2}{n_s n_i n_p c^3 \epsilon_0}}, \Delta k = k_p - k_s - k_i$$

و $K(\gamma)$ انتگرال بیضوی کامل نوع یک می‌باشد. تابع $cn[u, \gamma]$ $0 \leq \gamma \leq 1$ ، یک تابع $Cosinc$ بیضوی ژاکوبی دو پارامتری متناوب است که در $u=0$ ماکزیمم مقدار خود را دارد. بنابراین می‌توان با داشتن اطلاعات اولیه، طولی از کریستال را که در آن میزان شدت سیگنال تقویت شده ماکزیمم می‌گردد به دست آورد:

$$L_{peak} = K(\gamma) \sqrt{\frac{I_{p0}}{I'_{p0}}} \frac{\gamma}{\Gamma} \quad (۲)$$

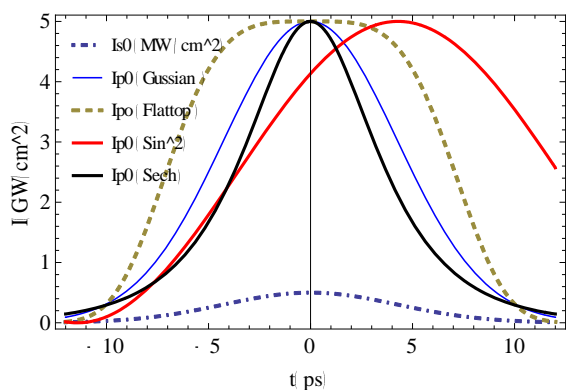
تاثیر شکل پروفایل‌ها بر فرآیند تقویت پارامتری:

برای بررسی تاثیر شکل پروفایل پالس‌های برهم کنش کننده لازم است دید کلی از مفهوم فیزیکی آن به دست آوریم. ابتدا دو پالس پمپ و سیگنال گوسی را در نظر بگیرید و فرض کنید طول پالس سیگنال بسیار کوچکتر از طول پمپ باشد در این حالت تمام قسمت‌های سیگنال شدت یکسانی از پمپ را تجربه خواهند کرد. بنابراین پهنای باند بهره حداکثر و به اصطلاح پهنای باند بهره کامل را خواهیم داشت. با اینحال از آنجا که بخش بسیار زیادی از پمپ بدون استفاده باقی می‌ماند، (سیگنالی در آن قسمت‌ها حضور ندارد) بازده کاهش می‌یابد. حال اگر طول پالس سیگنال برابر طول پمپ باشد با وجود اینکه می‌توان از تمام قسمت‌های پمپ استفاده کرد اما

^۱Optical Parametric Chirped Pulse Amplification

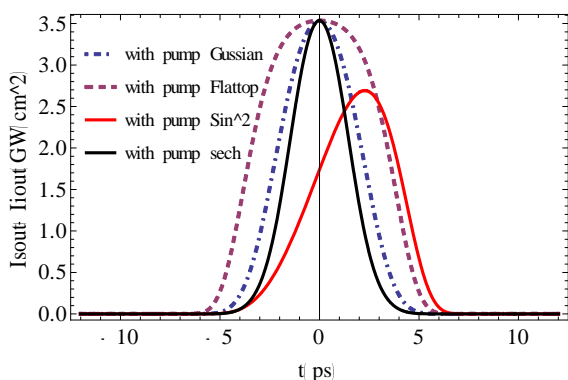
^۲Three waves mixing

^۳local approximation



شکل ۱: پروفایل‌های گوسی، تخت، \sin^2 و sech

حال با کمک معادلات به دست آمده (معادلات ۱) پالس سیگنال و ایدلر تقویت شده را برای پالس‌های پمپ متفاوت به دست می‌آوریم (شکل ۲).



شکل ۲: پالس‌های سیگنال و ایدلر تقویت شده برای پمپ‌های متفاوت گوسی، تخت، \sin^2 و sech

نتایج این محاسبات نشان می‌دهد پالس سیگنال و ایدلر تقویت شده برای پروفایل پمپ گوسی و sech با وجود داشتن شدتی برابر، نسبت به پروفایل‌های پمپ تخت باریکتر می‌باشد. همچنین مشاهده می‌کنیم این تقویت برای پروفایل پمپ \sin^2 هم نامتقارن بوده و هم با کاهش شدید شدت همراه شده است. بنابراین محاسبات را برای سه پروفایل گوسی، تخت و sech ادامه می‌دهیم.

همان‌طور که ذکر شد طول کریستال نیز فاکتور مهمی برای طراحی به‌شمار می‌رود. شکل ۳ میزان تغییر پالس سیگنال تقویت شده را برای طول‌های متفاوت کریستال و درمورد پروفایل‌های مورد بحث نشان می‌دهد:

بخش‌های متفاوت سیگنال، شدت‌های متفاوتی از پمپ را خواهند دید و به دلیل چیرپ بودن پالس سیگنال، طول موج‌های متفاوت به‌میزان متفاوتی تقویت می‌شوند. بنابراین برعکس حالت قبل پهنای باند بهره حداقل و بازده بالایی خواهیم داشت. (بزرگتر بودن طول پالس سیگنال نیز به دلیل تقویت نشدن بخش‌هایی از سیگنال به هیچ وجه گزینه مناسبی برای تقویت نمی‌باشد). از آنجا که حداکثر کردن پهنای باند و بازده پارامتری از ملزومات طراحی در OPCPAها می‌باشد، داشتن طول و پروفایل مناسبی از پالس‌های برهم-کنش کننده بسیار مهم خواهد بود. از طرفی با توجه به تاثیر مستقیم پالس پمپ بر بهره پارامتری کارآمدترین گزینه تغییر پروفایل پمپ می‌باشد. بنابراین فاکتور EBP^{\dagger} را که حاصل ضرب پهنای باند و بازده پارامتری می‌باشد را تعریف کرده و به دنبال حداکثر کردن آن می‌باشیم [۴].

اولین راه حل درمورد حداکثر کردن فاکتور EBP در تقویت کننده‌های با بهره بالا ($I_p/I_s=10^6$) مانند پیش تقویت کننده‌ها^۵ استفاده از پالس پمپی با پروفایل تخت و طولی تقریباً مشابه با طول پالس سیگنال می‌باشد. با این روش هم از تمام پالس پمپ استفاده می‌ود و هم تمام بخش‌های سیگنال با شدت یکسانی از پمپ تقویت می‌شوند.

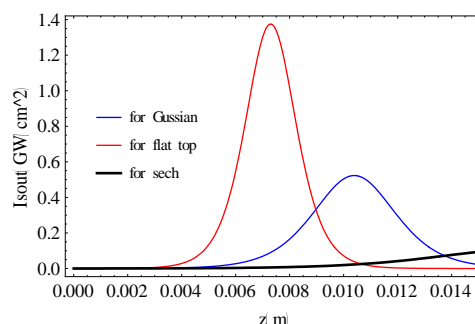
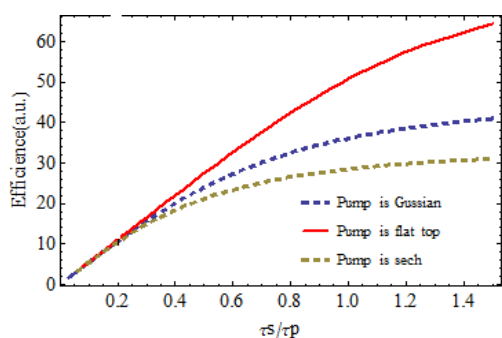
نتایج محاسبات عددی

برای بررسی مطالب ارائه شده یک سیستم OPCPA تک مرحله ای با طول موج سیگنال 1064nm ، طول موج پمپ 532nm ، طول پالس پمپ 10ps ، شدت پمپ 10GW/cm^2 و شدت سیگنال 0.5Mw/cm^2 را در نظر می‌گیریم. شکل ۱ نمودار چند پروفایل را که در شبیه سازی‌ها به کار گرفته شده است نمایش می‌دهد.

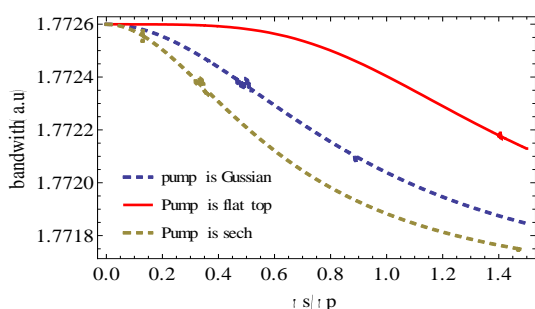
[†] Efficiency Bandwidth Product

^۵ Pre-amplifier

(الف)



(ب)



شکل ۴: الف) بازده و ب) پهنای باند پارامتری برای پالس‌های پمپ تخت و sech و گوسی

نتیجه‌گیری

با توجه به محاسبات عددی انجام شده می‌توان تاثیر پروفایل‌ها و طول پالس‌های برهم‌کنش کننده را در تقویت پارامتری مشاهده کرد. این نتایج بیان می‌کنند داشتن پروفایل تخت می‌تواند تاثیر به‌سزایی در خروجی تقویت کننده و تعیین طول کریستال داشته باشد.

مراجع

- [۱] J.A. ARMSTRONG, N. BLGEMEERGEN., " Interactions between Light Waves in a Nonlinear Dielectric." PH YSI CAL REVIEW, ۱۲۷,(۱۹۶۲).
- [۲] R.A. Baumgartner, R. Byer, Optical parametric amplification, Quantum Electronics, IEEE Journal of, ۱۵ (۱۹۷۹) ۴۳۲-۴۴۴.
- [۳] J. Moses, S.-W. Huang, Conformal profile theory for performance scaling of ultrabroadband optical parametric chirped pulse amplification, J. Opt. Soc. Am. B,(۲۰۱۱),۲۸,۸۱۲-۸۳۱.
- [۴] I.N. Ross, P. Matousek, G.H.C. New, K. Osvay, Analysis and optimization of optical parametric chirped pulse amplification, J. Opt. Soc. Am. B, ۱۹ (۲۰۰۲) ۲۹۴۵-۲۹۵۶.

شکل ۳: شدت سیگنال تقویت شده برحسب طول برهم‌کنش و برای پروفایل‌های گوسی، تخت و sech مشاهده می‌کنیم برای طول مشخصی از برهم‌کنش، این پالس تخت است که می‌تواند گزینه مناسب باشد، چرا که برای دستیابی به انرژی یکسان نیاز به طول برهم‌کنش کوچکتری نسبت به دو پالس دیگر دارد. در قسمت بعد با توجه به معادلات زیر میزان پهنای باند و بازده را برای این پروفایل‌ها به‌دست می‌آوریم.

$$\eta = \int \frac{I_s(L) + I_i(L)}{I_{p0}} dt \quad (۳)$$

$$\Delta\omega = \left(\frac{\int \omega^2 I_s(\omega) d\omega}{\int I_s(\omega) d\omega} \right)^{0.5}$$

شکل ۴ بازده پارامتری (الف) و پهنای باند (ب) پالس سیگنال تقویت شده را نمایش می‌دهد، مشاهده می‌کنیم که هم میزان پهنای باند و هم بازده پارامتری برای پالس تخت ماکزیمم می‌باشد و این به معنی حداکثر شدن فاکتور EBP برای این پروفایل می‌باشد.